

## 2SK56

## シリコン Nチャンネル接合型 FET/Si N-Channel Junction FET

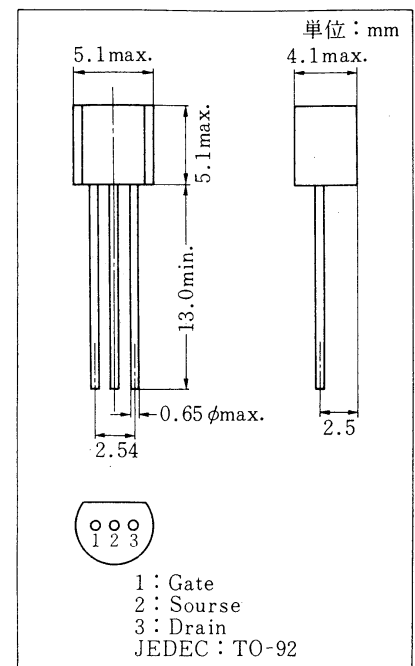
## 高周波増幅用/RF Amplifier

## 特 徴

- 低電圧, 低電流で利得が高い。
- 帰還容量  $C_{rss}$  が小さい。

最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース電圧	$V_{DS}$	10	V
ドレイン・ゲート電圧	$V_{DG}$	10	V
ドレイン電流	$I_D$	10	mA
ゲート電流	$I_G$	10	mA
許容損失	$P_t$	100	mW
接合部温度	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+125	$^\circ\text{C}$

電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	記 号	条 件	min.	typ.	max.	単 位
ゲートシャ断電流	$-I_{GSS}$	$-V_{GS}=1V, V_{DS}=0$			0.5	$\mu\text{A}$
ドレイン電流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0$	0.7		10	mA
ゲート・ソースシャ断電圧	$-V_{GSC}$	$V_{GSC}=5V, I_{DS}=10\mu\text{A}$			4	V
相互コンダクタンス	$g_m$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0, f=1\text{MHz}$		4		mS
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0, f=1\text{MHz}$		4		pF
出力容量	$C_{oss}$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0, f=1\text{MHz}$		3		pF
帰還容量	$C_{rss}$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0, f=1\text{MHz}$		0.1		pF
雑音指数	NF	$V_{DS}=5V, I_{DS}=1\text{mA}, f=100\text{MHz}$			4.5	dB
電力利得	$G_{ps}$	$V_{DS}=5V, I_{DS}=1\text{mA}, f=100\text{MHz}$	12			dB

$I_{DSS}$  により下表のように分類し, 現品表示しています。

$I_{DSS}$ (mA)	0.7~3.0	2.0~5.0	4.5~10.0
分類	P	Q	R